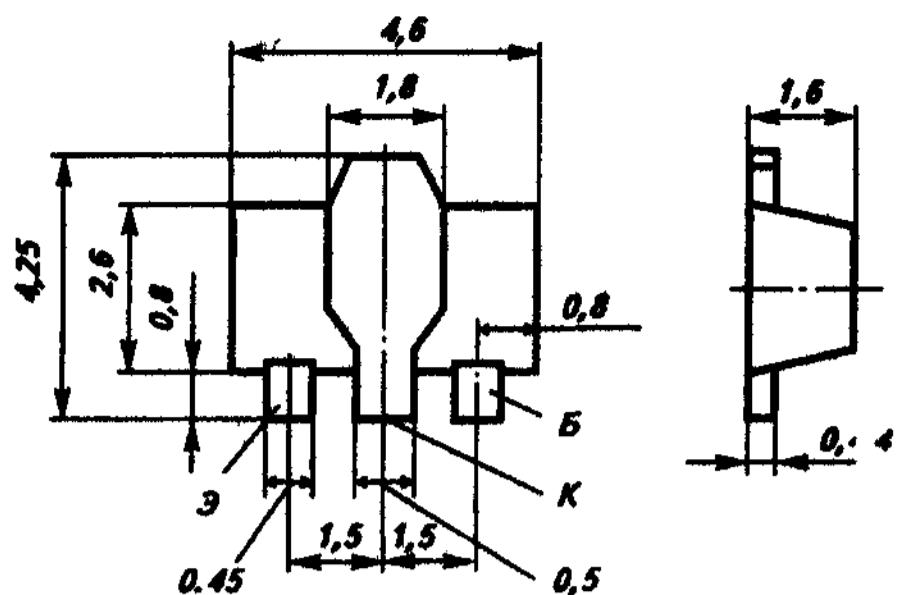


□ КТ666А9



Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* универсальный. Предназначен для применения в генераторах отклонения передающих телевизионных камер высокой четкости на трубках с дефлекторной системой отклонения. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 0,1 г.

KT666A9

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_{\beta} = 5$ мА,
не менее

50

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В,
 $f_k = 1,5$ мА,
не менее

60 МГц

Граничное напряжение при $I_{\beta} = 30$ мА, не менее

250 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 2$ мА,
не более

0,8 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 2$ мА, не более ..

1,2 В

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 300$ В, не более

0,1 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{кб} = 5$ В, не более

1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

300 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{б\beta} = 1$ кОм

300 В

Постоянное напряжение база-эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора

20 мА

Импульсный ток коллектора при $t_i = 500$ мкс

50 мА

Постоянный ток базы

5 мА

Импульсный ток базы при $t_i = 500$ мкс

10 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

с теплоотводом¹ при $T_k = -60 \dots +25^\circ\text{C}$

1 Вт

без теплоотвода² при $T = -60 \dots +25^\circ\text{C}$

0,3 Вт

Температура *p-n* перехода

+150°C

Температура окружающей среды

-60...+100°C

¹ При $T_k > +25^\circ\text{C}$

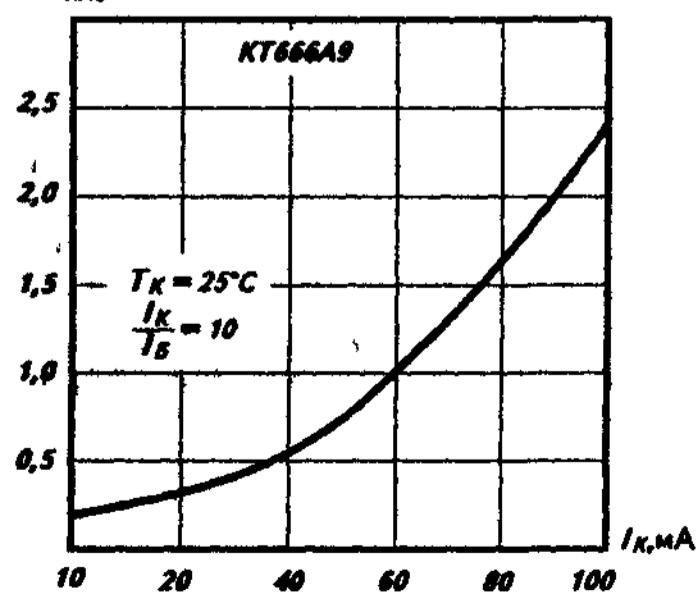
$$P_{k,\max} = (150 - T_k) / 125, \text{ Вт}$$

² При $T > +25^\circ\text{C}$

$$P_{k,\max} = (150 - T) / 416, \text{ Вт}$$

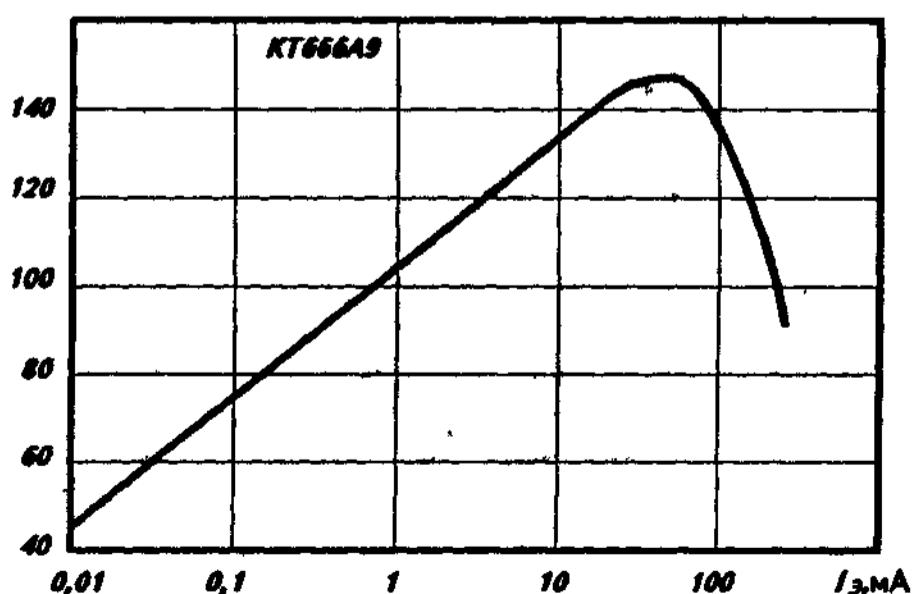
Пайку выводов рекомендуется проводить с применением лудящих паст и припоев на расстоянии не менее 0,15 мм от корпуса транзистора, время пайки не более 4 с, температура пайки не более +265°C.

$U_{кэ,нас}, \text{В}$



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора

h_{213}



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.